

公司概況資料表

**以下資料由GCS Holdings, Inc.(環宇通訊半導體控股股份有限公司)及其推薦證券商提供，資料若有錯誤、遺漏或虛偽不實，均由該公司及其推薦證券商負責。**

**以下揭露之認購價格及依據等資訊，係申請登錄興櫃公司與其推薦證券商依認購當時綜合考量各種因素後所議定。由於興櫃公司財務業務狀況及資本市場將隨時空而變動，投資人切勿以上開資訊作為投資判斷之唯一依據，務請特別注意**

** 認購相關資訊**

**** [**公司簡介**](#公司簡介)

**** [**主要業務項目**](#主要業務項目)

**** [**最近五年度簡明損益表及申請年度截至最近月份止之自結損益表**](#最近五年度簡明損益表及申請年度截至最近月份止之自結損益表)

**** [**最近五年度簡明資產負債表**](#最近五年度簡明資產負債表)

**** [**最近三年度財務比率**](#最近三年度財務比率及股利發放情形)

**公司名稱：GCS Holdings, Inc.環宇通訊半導體控股股份有限公司(股票代號：4991)**

|  |  |
| --- | --- |
| 輔導推薦證券商 | 中國信託綜合證券股份有限公司 |
| 主辦輔導券商聯絡人電話 | 陳皇慧02-8780-8867 轉2020 |
| 註冊地國 | 英屬開曼群島 |
| 訴訟及非訟代理人 | 黃大倫 |

|  |
| --- |
| 輔導推薦證券商認購**GCS Holdings, Inc.**公司股票之相關資訊 |
| 證券商名稱 | 中國信託綜合證券 | 兆豐證券 |
| 認購日期 | 101年3月28日 |
| 認購股數（股） | 657,000 | 438,000 |
| 認購占擬櫃檯買賣股份總數之比率 | 1.8% | 1.2% |
| 認購價格 | 新台幣35元 |
| 認購價格之訂定依據及方式 | GCS Holding, Inc.主要從事砷化鎵/磷化銦/氮化鎵高階射頻及光電元件晶圓製造代工、相關智慧財產權授權與先進光電產品之研究、開發、製造及銷售業務。本集團主要營運地位於美國加州，近年來合併營收皆呈現成長狀態。本次興櫃認購價格訂定依一般市場承銷價格訂定模式，經參考同業之前四季本益比約為14.49~20.55倍之間，最近一季股價淨值比為1.27~2.16倍之間，以採樣個股本益比及本淨比區間推估其價格約為21~69元，另綜合考量該公司財務架構、獲利能力及所處產業未來成長性，以及興櫃市場流動性不足之風險，由本證券承銷商與該公司共同議定興櫃認購價格為35元，應尚屬合理。(註：申請登錄興櫃時點計算) |

|  |
| --- |
| **公司簡介(公司介紹、歷史沿革、經營理念、未來展望等)** |
| **公司介紹 ：**GCS Holding, Inc. (環宇通訊半導體控股股份有限公司；以下簡稱本公司)，係為因應回台申請登錄興櫃及第一上櫃於西元(以下同)2010年11月30日於開曼群島設立之控股公司，並於2010年12月28日與Global Communication Semiconductors, Inc.股東完成換股，至此GCS Holding, Inc.成為本集團之控股母公司。此外，本集團主要係從事砷化鎵/磷化銦/氮化鎵高階射頻及光電元件晶圓製造代工、相關智慧財產權授權與先進光電產品之研究、開發、製造及銷售業務。本集團主要營運地位於美國加州，是美國在射頻和光電元件晶圓領域裡領域裡之技術領導者和唯一純專業晶圓製造廠。**集團架構**

|  |
| --- |
| GCS Holdings, Inc.Cayman Islands |
|  |  |
| Global Communication Semiconductors, LLC.USA |

**歷史沿革：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期 |  | 記事 |
| 1997年8月 |  | GCS USA於美國加州托倫市成立及設廠 |
| 1998年12月 |  | 成功開發InGaP HBT技術 |
| 1999年7月 |  | 獲美國IDM大廠Anadigics簽訂InGaP HBT技術轉移合約 |
| 1999年8月 |  | 獲日商Compound Semiconductor代工合約 |
| 1999年10月 |  | ISO 9001-2000 認證通過 |
| 2000年5月 |  | 成功開發砷化鎵(GaAs) PIN 光探測器 (Photodiode) |
| 2000年6月 |  | 獲美商Celeritek PHEMT 手機功率放大器量產合約 |
| 2001年4月 |  | 成功開發高壓InGaP HBT 技術 |
| 2001年8月 |  | 成功開發磷化銦HBT技術 |
| 2001年12月 |  | 成功開發InGaAs PIN 光探測器 (Photodiode) |
| 2002年1月 |  | 獲日商WCDMA 手機功率放大器認證成功 |
| 2003年4月 |  | 開始量產無線射頻0.5 微米PHEMT Switch (開關) |
| 2003年7月 |  | 開始提供光電元件晶圓代工業務 |
| 2004年3月 |  | 成功地開發世界最快速磷化銦HBT技術 (Ft > 300 GHz)，適用於光通訊40-100G Trans-impedance Amplifier (TIA) 和高速測試儀器IC |
| 2004年6月 |  | 獲美國IDM大廠GSM手機功率放大器認證成功 |
| 2005年6月 |  | 聘請Mr. Jerry Curtis為總經理及執行長 |
| 2006年1月 |  | 獲美商IDM廠 WJ Communication 多樣 砷化鎵技術和產品轉移合約，並簽訂長期晶圓代工合約 |
| 2006年10月 |  | 獲得美商IDM廠 Xponent 光電技術和產品轉移合約，並簽訂長期晶圓代工合約 |
| 2006年12月 |  | 獲加拿大光電元件商光電技術和產品轉移合約，並簽訂長期晶圓代工合約 |
| 2007年1月 |  | 成功轉移 WJ Communication 多樣砷化鎵技術和產品 |
| 2007年6月 |  | 轉移砷化鎵無線射頻技術和客戶產品至宏捷半導體公司 |
| 2007年7月 |  | 開始量產 WJ Communication 多樣產品 |
| 2008年3月 |  | 獲日商光電技術和產品轉移合約，並簽訂長期晶圓代工合約 |
| 2008年6月 |  | 開始美國氮化鎵 (GaN) 廠商代工業務 |
| 2008年7月 |  | 簽訂APD開發合約 |
| 2008年8月 |  | 開始砷化鎵聚光型太陽能電池晶圓代工業務 |
| 2009年10月 |  | 獲美國IDM廠射頻功率 (RF Power) 氮化鎵 (GaN) 技術和產品轉移計畫，並簽訂長期晶圓代工合約 |
| 2010年11月 |  | 獲世界級矽晶圓代工廠簽訂多項砷化鎵 (InGaP HBT and PHEMT) 技術轉移合約 |
| 2010年11月 |  | 集團控股公司GCS Holdings, Inc.設立於英屬開曼群島 |
| 2010年12月 |  | GCS Holdings, Inc.與GCS USA進行換股，集團重組完成後，GCS Holdings, Inc.之股本為新臺幣306,946仟元。 |
| 2011年2月 |  | 獲得國際IDM大廠氮化鎵GaN研發計畫 |
| 2011年2月 |  | 簽訂VCSEL開發合約 |
| 2011年7月 |  | 獲美商氮化矽(SiC)高功率元件晶圆代工 |
| 2011年8月 |  | 成功轉移多項砷化鎵 (InGaP HBT and PHEMT) 技術至世界級矽晶圓代工廠 |
| 2011年10月  |  | 獲美商氮化鎵(GaN/Si)高功率射頻元件認證成功 |
| 2011年11月 |  | 獲美商Nitronex簽訂長期晶圓代工合約 |
| 2012年2月  |  | 獲得國際IDM大廠衛星通訊電子用HBT代工訂單 |

**經營理念**誠信、正直和公開最高的品質創新的產品與全方位的服務對客戶、股東、員工和社會的責任及承諾**未來展望**領導技術創新，領先創造價值完整品牌產品，加速成長獲利策略合縱連橫，加速市場佔有整體經營管理，領先客服品質 |

 

|  |
| --- |
| **主要業務項目：**本集團主要係從事砷化鎵/磷化銦/氮化鎵高階射頻及光電元件晶圓製造代工、相關智慧財產權授權與先進光電產品之研究、開發、製造及銷售業務。  |
| 公司所屬產業之上、中、下游結構圖：砷化鎵等三五族化合物半導體晶圓製造廠產業上游關鍵材料為磊晶圓，包括MOCVD及MBE磊晶技術，至於中游為IC設計、晶圓製造及封測，其下游則為模組及系統

|  |  |
| --- | --- |
| 產業鏈 | 廠商名稱 |
| 上游 | 晶圓磊晶 | 台灣 | 全新光電、高平磊晶等 |
| 國外 | IQE(MBE Technology), Kopin, Hitachi Cable, Picogiga, Furukawa Electric, Sumitomo,IntelliEpi等 |
| 中游 | 設計 | 台灣 | IDM | 全訊、漢威  |
| Fabless | 天弓、朗弗、華新科、Micro Mobio等 |
| 中國 | Fabless | RDA Micro, RFMC, GrandICs, Glentel等 |
| 國外 | ID | RF Micro Devices, Skyworks, Avago Technologies, TriQuint Semiconductors, Anadgics, Renesas, NEC, Matsushita (Panasonic), Sharp, Sony, Toshiba, MuRata |
| Fabless | SiGe Semiconductor, SST, RFAxis, Microsemi等 |
| 晶圓製造 | 台灣 | 穩懋、聯穎、宏捷、漢威、全訊等 |
| 國外 | RFMD, Skyworks, Avago Technologies, TriQuint Semiconductors, Anadigics, Renesas, NEC, Matsushita (Panasonic), Sharp, Sony, Toshiba, MuRata,GCS |
| 封裝 | 台灣 | 菱生、同欣、國基、典範 |
| 測試 | 台灣 | 全智、日月光、京元電、矽格 |
| 下游 | 模組及系統 | 台灣 | 宏達電、明基、大霸、廣達、華寶、華冠、正文、建漢、明泰、雷凌等 |
| 國外 | Nokia, Samsung, LG, Sony-Ericsson, Motorola, Atheros等 |

 |
| 產品名稱 | 產品圖示及介紹 | 重要用途或功能 | 最近一年度營收金額(仟元) | 佔總營收比重(%) |
| 射頻元件晶圓 | 砷化鎵晶圓代工 | 功率放大器(PA)及射頻開關(Switch) | 714,117 | 77.84% |
| 光電元件晶圓 | 砷化鎵晶圓代工 | 光探測器晶片 | 203,312 | 22.16% |
| 總計 |  |  | 917,429 | 100.00% |

 

|  |
| --- |
| **最近五年度簡明損益表及申請年度截至最近月份止之自結損益表** 單位：新台幣仟元  |
| 年度項目 | 年 | 97年(擬制性) | 98年(擬制性) | 99年(擬制性) | 100年**(自結數)(註)** | 101 年截至2月份止**(自結數)(註)** |
| 營業收入 | - | 693,582 | 701,947 | 864,496 | 917,429 | 108,196 |
| 營業毛利 | - | 110,491 | 197,680 | 297,621 | 333,929 | 35,014 |
| 毛利率(%) | - | 15.93% | 28.16% | 34.42% | 36.40% | 32.36% |
| 營業外收入 | - | 676 | 1,386 | 3,516 | 221 | 39 |
| 營業外支出 | - | (2,663) | (1,551) | (321) | (120) | - |
| 稅前損益 | - | (19,861) | 44,583 | 75,734 | 76,495 | (3,588) |
| 稅後損益 | - | (19,886) | 101,480 | 117,826 | 67,751 | (3,588) |
| 每股盈餘（元） | - | (0.65) | 3.31 | 3.84 | 2.05 | (0.10) |
| 股利發放 | 現金股利(元) | - | - | - | - | 尚未分配盈餘 | - |
| 股票股利(資本公積轉增資)(元) | - | - | - | - | 尚未分配盈餘 | - |
| 股票股利(盈餘轉增資)(元) | - | - | - | - | 尚未分配盈餘 | - |

**(註)係自結數字，未經會計師查核簽證，因此可能與會計師查核結果存有差異，請投資人於參考時審慎評估。**

|  |
| --- |
| **最近五年度簡明資產負債表**單位：新台幣仟元  單位：新台幣仟元 |
| 年度項目 | 年 | 97年(擬制性) | 98年(擬制性) | 99年 | 100年**(自結數)(註)** |
| 流動資產 | - | 182,364 | 227,236 | 315,042 | 554,840 |
| 基金及長期投資 | - | 10,253 | 10,000 | 4,783 | 5,493 |
| 固定資產 | - | 45,052 | 34,755 | 33,598 | 102,552 |
| 無形資產 | - | 2,710 | 1,682 | 1,501 | 3,634 |
| 其他資產 | - | - | 36,077 | 54,260 | 82,815 |
| 資產總額 | - | 240,379 | 309,750 | 409,184 | 749,334 |
| 流動負債 | - | - | 60,661 | 71,062 | 66,612 | 98,252 |
| - | - | 60,661 | 71,062 | 66,612 | 尚未分配 |
| 長期負債 | - | 36,483 | - | - | - |
| 其他負債 | - | - | - | - | - |
| 負債總額 | - | - | 97,144 | 71,062 | 66,612 | 98,252 |
| - | - | 97,144 | 71,062 | 66,612 | 尚未分配 |
| 股本 | - | 306,278 | 306,309 | 306,946 | 364,906 |
| 資本公積 | - | 1,751,616 | 1,752,182 | 28,359 | 189,048 |
| 保留盈餘 | - |  | (1,919,703) | (1,818,223) | 11,522 | 79,274 |
| - |  | (1,919,703) | (1,818,223) | 11,522 | 尚未分配 |
| 長期股權投資未實現跌價損失 | - | - | - | - | - |
| 累積換算調整數 | - | 5,044 | (1,580) | (4,255) | 17,854 |
| 股東權益總額 | 分配前 | - | 143,235 | 238,688 | 342,572 | 651,082 |
| 分配後 | - | 143,235 | 238,688 | 342,572 | 尚未分配 |

 

|  |
| --- |
| **最近三年度財務比率** |
| 年 度項 目 | 98年(擬制性) | 99年(擬制性) | 100年**(自結數)(註)** |
| **財****務****比****率** | 毛利率(%) | 28.16% | 34.42% | 36.40% |
| 流動比率(%) | 319.77% | 472.95% | 564.71% |
| 應收帳款天數(天) | 40 | 40 | 48 |
| 存貨週轉天數(天) | 71 | 74 | 84 |
| 負債比率(%) | 22.94% | 16.28% | 13.11% |

 

投資人若欲查詢該公司更詳細之資料請連結至[**公開資訊觀測站**](http://newmops.tse.com.tw)!!